



Э Т И К Е Т К А

Микросхема ОС805УИЗ

Микросхема типа ОС805УИЗ соответствует техническим условиям ОУ.347.005 СЧТУ

Функциональное назначение

ОС805УИЗ - усилитель считывания

Режим работы

Напряжение питания $E, В$ $+5 \pm 10\%$; минус $2,4 \pm 10\%$
 Ток потребления $I_{пот}, мА$, не более $12,0$; $8,0$

Основные электрические параметры микросхема при температуре $+25 \pm 10^\circ C$

Верхний уровень выходного сигнала $U_{вг}, В$, не менее $3,0$
 Нижний уровень выходного сигнала $U_{нг}, В$, не более $0,25$
 Длительность выходного сигнала $t_{ог}, мкс$, не менее $0,25$
 Частота следования сигнала $F_u, кГц$, не более 125
 Порог срабатывания микросхемы ОС805УИЗ и номиналы выносных резисторов приведены в табл. 7

Таблица 7

Номер партии		Номер микросхемы				
986		4				
Порог срабатывания микросхемы, $U_{пор}, мВ$						
Напряжение питания, В	Сопротивление между 8 и 10 выводами микросхемы R 6, кОм	Температура окружающей среды, $^\circ C$				
		+25 ± 5	+70 ± 3	минус 40 ± 3		
$+4,5$	$-2,64$	Резистор $0,125 \pm 5\%$ ГОСТ 7113 - 71	3,90	4,2	3,8	3,6
			2,40	5,6	5,0	5,0
			1,80	7,6	6,2	6,4
			1,30	9,6	8,6	9,6
			0,91	12,6		
			0,68	13,4		

Номинал сопротивления между выводами 1 и 3 микросхемы R I = 1,3 кОм

Содержание драгоценных металлов

"Золото" $0,0030$ мг, "Серебро" _____ мг

Рекомендации по установке микросхем

- При монтаже микросхем не разрешается изгиб выводов ближе 2,0мм от корпуса с радиусом закругления менее 2 мм. Микросхему установить без зазора перпендикулярно по отношению к плате.
- Пайку выводов микросхемы производить на расстоянии не менее 1 мм от корпуса паяльником мощностью не более 60 Вт в течение 3-6 с припоем ПОСК 50-18, ПОС 61, ПОССу 61-0,5 ГОСТ 21931-76.
- Пайку выводов рекомендуется производить одножальным паяльником:
- температура жала паяльника не более $280^\circ C$;
 - время касания к каждому выводу не более 3 с;
 - интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с;
 - расстояние от корпуса до места пайки не менее 1 мм;
 - заземление жала паяльника;
- грушевым паяльником:
- температура расплавленного припоя не более $265^\circ C$;
 - время воздействия не более 3 с; интервал между повторными пайками одной микросхемы не менее 5 мин;
 - расстояние от корпуса до места пайки /по длине вывода/ не менее 1 мм;
 - заземление жала паяльника.
- Дужение выводов микросхем рекомендуется производить методом погружения в расплавленный припой:
- температура припоя не более $250^\circ C$;
 - время погружения не более 2 с;
 - расстояние от корпуса до зеркала припоя /по длине вывода/ не менее 1 мм;
 - допустимое количество погружений одного и того же вывода не более 2;
 - интервал между погружениями не менее 5 мин;
 - припой и флюсы выбравятся в соответствии с ОСТ II.029.001-74.

Примечание: При пайке выводов следует принимать меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с ОСТ 4ГО.033.000, для влагозащиты применять лак УР-23Г ТУ6-10-863-76 или ЗП-730 ГОСТ 20624-75, приклейку производить клеями АК-20 ТУ 6-10-1293-72 и мастикой ЛН по ИЮ.045.103.

Примечание. Для очистки плат от флюса после монтажа микросхем, влагозащиты и приклейки микросхем допускается применять любые моющие жидкости, лаки и клеи, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку, материалы корпусов после согласования с предприятием п/я А-7538 и проведения соответствующих испытаний.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов /в том числе шин "Питание" и "Земля"/ к корпусу и выводам микросхем, не используемым согласно схеме электрической принципиальной.

При ремонте аппаратуры замену микросхем производить только при отключенных источниках питания.

После монтажа микросхем должны быть защищены в соответствии с руководством по применению ОК.348.010.

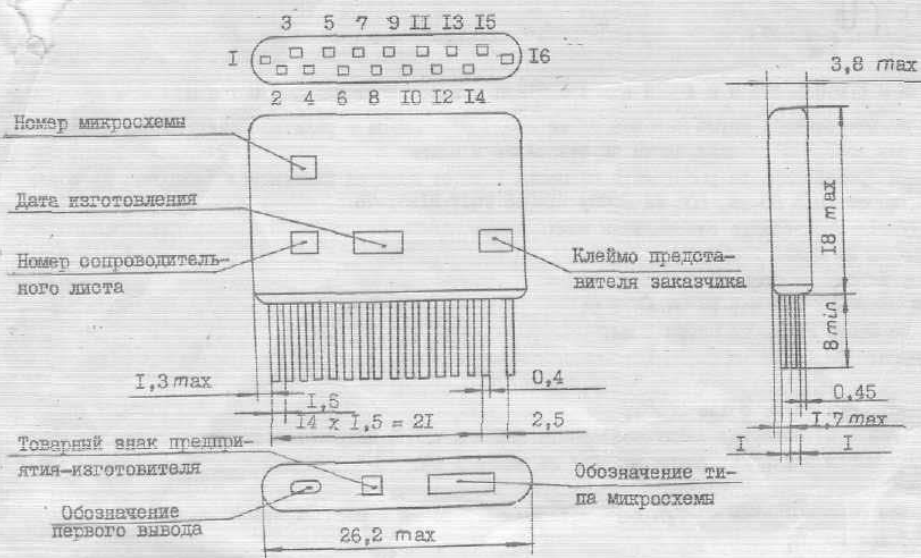
Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от минус 10 до + 65
Относительная влажность воздуха при температуре + 40°С, %	98
Атмосферное давление, мм рт.ст.	$1 \cdot 10^{-6}$
Вибрация в диапазоне от 5 до 5000 Гц с ускорением g , до	40
Многочисленные удары с ускорением g , до	75
Длинные (центробежные) нагрузки с ускорением g , до	150
Сдиночные удары с ускорением g , до	150
Время гарантийной наработки 25000 ч.	
Срок хранения 25 лет.	

Гарантии предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставленной микросхемы требованиям СТУ и СЧТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных настоящим стандартом и СЧТУ. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления нанесенной на микросхеме. Предприятие-изготовитель проводит исследования и анализ причин отказов микросхем, рекламированных потребителем, и доводит результаты рассмотрения до потребителя в соответствии с "Положением о входном контроле..." ред. 3-73.

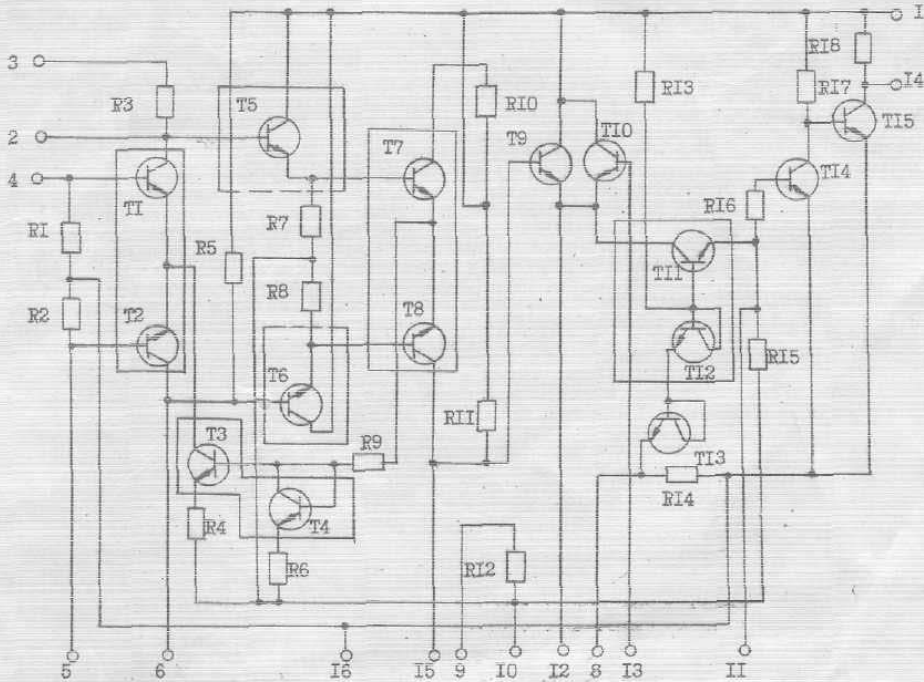
Габаритный чертеж



1. Неуказанные предельные отклонения расстояний между первым выводом и любым другим $\pm 0,1$ мм на длине выводов до 0,7 мм от их заливки компаундом.
2. Нумерация выводов показана условно.
3. Допускаются отдельные точечные наплывы припоя на выводах, увеличивающие сечение вывода до 0,5 x 0,55 мм.

Масса не более 3,0 г.

Схема электрическая принципиальная



- R1, R2 - Резисторы 1 кОм ± 10%, 0,15 мВт; $R1 - R2 / R2 \leq 1\%$
- R3 - Резистор 10,5 кОм ± 10%, 1,21 мВт
- R4 - Резистор 0,5 кОм ± 10%, 0,25 мВт
- R5 - Резистор 12 кОм ± 10%, 1,41 мВт
- R6 - Резистор 0,3 кОм ± 10%, 0,45 мВт
- R7, R8 - Резисторы 3,3 кОм ± 10%, 4,52 мВт; $R7 - R8 / R8 \leq 2\%$
- R9 - Резистор 1,5 кОм ± 10%, 1,9 мВт
- R10, R11 - Резисторы 5,5 кОм ± 10%, 2,4 мВт; $R10 - R11 / R11 \leq 2\%$
- R12 - Резистор 2,4 кОм ± 5%, 3,65 мВт
- R13 - Резистор 9 кОм ± 10%, 2,7 мВт
- R14 - Резистор 0,2 кОм ± 7%, 0,5 мВт
- R15 - Резистор 2,0 кОм ± 10%, 4,0 мВт
- R16 - Резистор 0,5 кОм ± 10%, 2,8 мВт
- R17 - Резистор 4,7 кОм ± 10%, 7,0 мВт
- R18 - Резистор 2,4 кОм ± 10%, 12,1 мВт
- T1 - T2 - Микросхема интегральная ОС129НТ1Х ХМ3.456.042 СТУ
- T5 - T6, T7 - T8 - Микросхема интегральная ОС 129НТ1Х ХМ3.456.042 СТУ
- T3 - T4, T11 - T12 - Микросхема интегральная ОС129НТ1И ХМ3.456.042 СТУ
- T9 - Транзистор С2Т307Р-1 СЕО. 336.026 Д
- T10, T13 - Транзистор С2Т307В-1 СЕО. 336.026 Д
- T14, T15 - Транзистор С2Т307В-1 СЕО. 336.026 Д

Примечание: Допускается замена:

R2 на R1; R8 на R7; R11 на R10; $R1 - R2/R2 \leq 1\%$;
 $R7 - R8/R8 \leq 2\%$; $R10 - R11/R11 \leq 2\%$;
 ОС129НТ1И на ОС129НТ1Х

Схема функциональная

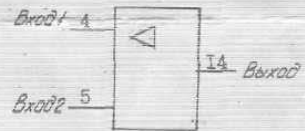


Таблица выводов

№ вывод	Назначение
1	Питание + 5 В
2	Контрольная точка
3	Регулировка
4	Вход 1
5	Вход 2
6	Контрольная точка
8	Регулировка
9	Регулировка
10	Питание - 2,4 В
11	Контрольная точка
12	Контрольная точка
13	Стрелка запрета
14	Выход
15	Контрольная точка
16	Общий

07.822

10.08.81

СТН 219



27.08.1981

Улаковски